

## СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОМОЩНЫХ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ БЕЛОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

Е. Е. Трусова, Е. Р. Кравцова

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Республика Бееларусь trusova@belstu.by

В настоящее время светодиодное освещение является одним из перспективнейших направлений технологий искусственного освещения, которое основано на использовании светодиодов как источника света. Использование высокомощных осветителей на основе полупроводниковых лазеров в автомобилестроении и коммунальном хозяйстве позволит улучшить как освещенность дорог, что должно позитивно сказаться на безопасности пешеходов, так и условия труда ряда трудовых категорий (водители, строители, машинисты поездов и т.д.). Относительная компактность размеров, высокая яркость и малая потребляемая мощность также делает высокомощные источники освещения на основе лазерных диодов перспективными кандидатами для использования в спасательной и военной технике.

люминесцентных преобразователей традиционно алюмоиттриевые гранаты, содержащие примесь ионов церия и/или других элементов, а также применяются оптически прозрачные керамики, изготавливаемые из алюмоиттриевого граната в виде порошка путем компактирования и спекания.

Альтернативным решением для монокристаллов и оптически прозрачных керамик являются стеклокристаллические материалы, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами: низкая стоимость (в более чем 30 раз ниже, чем монокристалл); высокая воспроизводимость при получении; отсутствие необходимости в сложном оборудовании; процесс получения отличается экономичностью и технологичностью; высокая фото- и термостабильность; экологичность (число циклов переработки не ограничено); производство может быть организовано на базе практически любого стекловаренного производства.

В случае использования синего лазера в качестве источника возбуждающего излучения важным является «внесение» в люминесцентный преобразователь центров рассеяния, что необходимо для получения рассеянного (а не узконаправленного) пучка света. В случае стеклокристаллических материалов ими выступают сами кристаллы люминофора, размер и количество которых возможно регулировать, варьируя условия кристаллизации стекла.

Постоянный рост рынка светодиодной техники будет стимулировать спрос на соответствующую продукцию с каждым годом. Кроме того, в виду более низкой стоимости, стеклокристаллические люминесцентные преобразователи и высокомощные источники света на их основе станут доступны гораздо большему кругу производителей.

Целью настоящей работы является разработка составов и технологии получения стеклокристаллических материалов для светоизлучающих устройств белого цвета свечения.

Исходные стекла синтезированы на основе стеклообразующей  $Y_2O_3-B_2O_3-Al_2O_3-SiO_2-CeO_2$  системы в газовой печи при максимальной температуре 1500±10°С. Отжиг стекол осуществлялся при 600°С. Стекла характеризуются плотностью 3368–3625 кг/м<sup>3</sup>, температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) – (37,02– 41,09)· $10^{-7}$  К<sup>-1</sup>, микротвердость экспериментальных стекол изменятся от 3984 до 6163 МПа. Для оценки химической стойкости используется гидролитическая классификация, в соответствии с которой исследуемые стекла относятся к III гидролитическому классу.

Получение стеклокристаллических материалов проводят двухступенчатого, в некоторых случаях даже многоступенчатого, режимов тепловой обработки, что связано с необходимостью образования на 1-ой ступени центров кристаллизации, а на 2-ой – формирования и роста кристаллов.

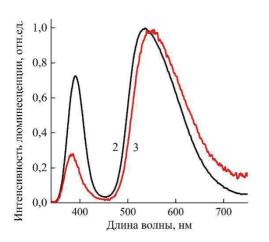


Для определения температур термообработки использован метод дифференциальносканирующей калориметрии. Разработан температурно-временной режим термообработки стекол в интервале 1150-1300 °C в течение 60 минут. Стеклокерамика с гранатовой фазой проявляется для всех составов стекол (рисунок 1). Однако, в случае стекла состава с минимальным содержанием оксида иттрия и содержанием оксида бора 25 мас. % формируется примесная фаза Y<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.

Особое внимание привлекает тонкая структура пиков. Наблюдаемая асимметрия указывает на образование гранатов с разной степенью замещения. Методом электронной микроскопии подтверждено образование кристаллов с типичной структурой граната. Средний размер кристаллов составляет 4-12 мкм. Отсутствие различных видов включений (поры, трещины или кристаллические отложения) указывает на высокую когерентность границ формирующихся кристаллов.

Спектры возбуждения люминесценции термообработанных стекол состоят из двух широких полос с максимумами 350 нм и 450 нм, которые соответствуют оптическим переходам иона церия. По сравнению с типичными полосами поглощения в гранатах, легированных церием, в термообработанных стеклах полосы более широкие и асимметричные. Эти особенности можно объяснить вкладом ионов Се<sup>3+</sup> с несколько иным окружением и, следовательно, кристаллическим полем и дополнительным поглощением Ce<sup>3+</sup> в области 350 нм в матрице стекла.

Фотолюминесценция термообработанных стекол основана на излучении Ce<sup>3+</sup>, которое состоит из двух широких сильно перекрывающихся полос, обусловленных расщеплением основного состояния на два подуровня. Локальное поле может сместить подуровни и, следовательно, спектральное положение полосы. В спектре люминесценции при возбуждении на длине волны 365 нм (рисунок 1) преобладает полоса при 530-550 нм, обусловленный эмиссией ионов Ce<sup>3+</sup> из структуры граната, тогда как менее интенсивная полоса с максимумом при 390 нм обусловлена эмиссией Ce<sup>3+</sup> из матрицы стекла. При возбуждении 442 нм наблюдается одна широкая полоса излучения с максимумом 530-550 нм.



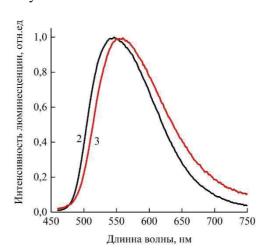


Рисунок 1 – Спектры люминесценции термообработанных стекол при возбуждении на длине волны 365 нм и 442 нм

Установлено, что пластинки (5х5х0.5) мм разработанного стеклокристаллического материала достаточно для использования в комбинации с 3 Вт синим лазером. Разработанные материалы будут выступать как в роли предлагаемого продукта самостоятельно, так и служить базой для разработки высокомощных источников света на основе синих полупроводниковых лазеров (компактных прожекторов для дронов, лазерных фар для автомобилей, фар для поездов и другой техники).